

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

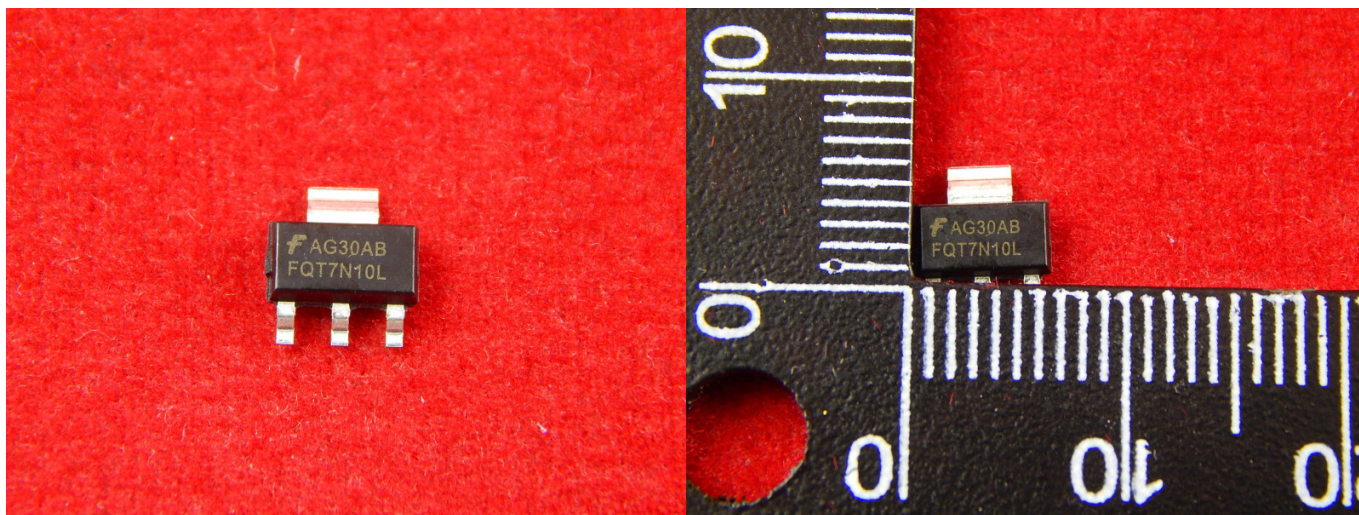
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15181

Цена в прайсе: 319 тг.

FQT7N10L мощный полевой МОП-транзистор, N-канальный



Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

Этот мощный МОП-транзистор с усилением N-каналов производится с использованием запатентованной планарной полосы Fairchild Semiconductor и технологии DMOS. Эта передовая технология MOSFET была специально разработана для уменьшения сопротивления в открытом состоянии, а также для обеспечения превосходных характеристик переключения и высокого уровня лавинной энергии. Эти устройства подходят для импульсных источников питания, аудиоусилителя, управления двигателем постоянного тока и приложений с переменным импульсным питанием.

Применение:

- LED телевизор;
- Бытовая техника;
- Осветительные приборы.

Спецификация:

- Конфигурация и полярность: N;
- Максимальное напряжение сток-исток: 100V;
- Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса: 1.7A;
- Сопротивление открытого канала (мин): 0.35Om;

- Диапазон номинальных напряжений затвора: 4.5-10V;
- Заряд затвора: 46нКл;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C.

Схема:

